2 0 - P 2 2

SLOW POSITRON SOURCE USING S-BAND ELECTRON LINEAR ACCELERATOR IN OSAKA UNIV.

Yosihide HONDA, Tamotsu YAMAMOTO, Shuichi OKUDA, Juzo OHKUMA, Takayoshi YAMAMOTO, Masanobu NUNOGAKI and Takio TOMIMASU *

Radiation Laboratory, The Institute of Scientific and Industrial Reserch, Osaka University, 8-1 Mihogaoka, Ibaraki, Osaka 567, Japan

ABSTRACT

Slow positron source using S-band electron linear accelerator was developed. The transport system of slow positron beam, so far, was made electrostatically. In this system, however, it was very difficult for measuring the number of transported positrons because of much background radiation. Therefore, positrons had to be transported far away from the production room. In this case, however, there were another problems such as the degradation of transport efficiency and existence of terrestrial magnetism. In order to avoid these problems, magnetic transport system was adopted instead of electrostatic one. In this paper, the design of magnetic transport system and the preliminary experimental results are presented.

阪大Sバンドライナックを用いた低速陽電子源

1.はじめに

これまで電場だけを用いた輸送系で陽電子量の測定を 行ってきたが、バックグラウンド放射線の量が非常に多 く、このため試料容器を陽電子発生部から遠く離さなけ ればならないこと、地磁気の影響が無視できず、磁気遮 蔽を装置全体に施す必要があること、などの理由により、 陽電子輸送方式を磁場輸送方式に変更し、この装置の設 計・製作及び電子ビームを用いた予備実験及び陽電子輸 送実験を行った。

2. 磁場輸送系の設計

陽電子をモデレーターから効率よく磁場を用いて引き 出し、且つ輸送するために、以下の点を考慮し設計を行っ た。特に重要となるのは、1)モデレーターから引き出さ れる陽電子ビームをどこまで絞ることができるかの評価、 及び2)放射線が陽電子発生室から、輸送系の壁の穴を通 して他室に漏洩するのを防ぐために設けてある曲管部で のドリフト量の評価である。

1)陽電子ビームの引き出しでは、ミラー磁場による反 射が起こる可能性がある。タングステンフォイルから放 出される陽電子がラーマ運動により他のタングステンフ

* FEL Res. Inst. Inc

イルに当たらないようにするためには、66以上の磁場を モデレーター内に作らなければならない。ビーム経を 1cm(約1/6)に絞るためにモデレーターの中心で約10G、 ミラー磁場は約220Gが得られるようコイルを配置した。 この時、反射を起こさないための陽電子速度は100eV以 上が必要である。

2)曲部での陽電子軌道のドリフトに関しては、磁場勾 配ドリフトによる像のシフトは、磁気ミラーで反射され る条件に近くなると急激に大きくなるが、これより小さ い磁場の時には曲率ドリフトの方が支配的である。曲率 ドリフトは陽電子のエネルギーか高くなるほど問題となっ てくるため、これを補正するために、曲部に補正コイル を設置することにした。

3. 実験装置

モデレーター中の磁場は100程度であるから地磁気の 影響が現れる。この影響を避けるためにこの最初のヘル ムホルツコイルを可動にした。また真空容器は、操作の しやすさ、放射化の問題等の理由からアルミ合金製であ る。真空に関しては、到達真空度を10⁻⁹Torr とするた め、2~3mおきにイオンポンプを設置してある。イオン ポンプ位置ではソレノイドコイルが分断されるため、こ の部分はヘルムホルツコイルで磁力線をつないである。 コイルの線材はアルミ線とし、被覆は通常の樹脂系統よ り耐熱が高い、平角の紙巻き線を使用している。コイル ボビンはコイルを巻いた後でも移動を可能にするために、 ユニット化し、最長でも1m程度である。実験は図1(b) 中でM4で示されている位置まで組み上げ、この部分で陽 電子像を観測することにした。

4. 電子を用いた輸送実験

本実験の目的は陽電子軌道シミュレーション用電子銃 を製作し、電子ビームを用いて予備実験を行うことで、 実際に起こるトラブルを事前に知ることであった。そこ で、陽電子ビームラインを組み上げていく過程で電子ビ ーム像のモニターを順次行いながら、M4位置まで陽電子 ビームラインを製作し、ここで全体を通しての計測を行っ た。この過程で得られた像を図2、3に示す((a)~(c) はM1~M3位置で得られた像に対応している)。実験は主 に電子銃付近の磁場分布を変化させ、電子の引き出し電 圧は1kVであった。それぞれの図に対応する各コイル電 流は、図-2に対しH1=3A、H2~H3=4.5~5A、H4~H5=5A、 S1=5A、S2~S4=10A、B1~B2=10Aで、図3ではH1=5A、H2 ~H3=4.5~5A, H4~H5=5A, S1=8A, S2~S4=10A, B1~ B2=10Aであった。。このうちM3での像はミラーを用いて 像を観測しているため、左右がM1、M2での像に対し反転 している。また片方の像が中心部で割れているように見 えるのは、蛍光板のためである。像の位置関係が水平面 から傾いているのは、ヘルムホルツコイルの軸がソレノ イドの軸と整合していないためと考えられる。図2のM1 位置での2つの電子ビーム像の平均距離はそれぞれ約 13mm、18mmである。この結果から電子引き出し部での磁 場勾配を大きくしたときには像間隔は縮まるが、これに 伴いラーマ半径が増大するため、像としては径が大きく なるのがわかる。図2で中空の像が得られているが、こ れは特に中心軸から離れた部分では、磁力線が電子銃の カソードと垂直に交差しないため、電子銃から放出され る電子は集団として磁力線に対しある角度を持って放出 されることになる。このため全体としてラーマ運動をす ることになり、中空の像が得られたと考えられる。従っ て、陽電子像の歪みも中心部から離れるほど顕著になる ことが予想される。この中空部分の径は電子銃を囲むミ ラー磁場を傾けることで、変化させることができるが、 2つの像から中空部分を取り除くことは、磁力線の向き を変えることだけでは不可能で、磁場の強度分布を変え なければならない。またM2位置では電子が曲部を通過し たため、ドリフトにより約1~2cm程度のシフトが観測さ れたが(このためビームが蛍光板の支えに当たり一部像 が欠けている)、M3位置では、電子は2カ所の曲率の符 号が異なる部分を通過するので、ドリフト方向が互いに





図-1(a)第1照射室内での陽電子輸送系の立面図 (b)陽電子輸送系の平面図

打ち消しあうため、像のシフトは顕著ではなかった。し かし、現実には曲部間でシフトが起こっているため、ビ ーム径が大きいときには調整が必要となる。像のシフト に関しては、ドリフトによるシフトとは別に、曲管の曲 率半径方向(外側)に像がシフトするのが観測された。 これは、曲部内の磁場は、理想的な場合と異なり、特に 外側でコイルの巻きむらにより曲管外に逃げてしまって いるため、あるいは曲部の磁場とヘルムホルツコイル、 ソレノイドコイル磁場との間で整合がとれていないため、 像は外側にシフトしたと考えられる。これを補正するた めのコイルを設置することで、像を歪ませることなく移 動させることができた。

5. 陽電子生成·輸送実験

低速陽電子ビーム発生実験は図1(b)のM4の位置まで組 み上げた段階で行った。計測は蛍光板付きMCP(浜松 ホトニクス製;F2225)をM4の位置に設置し、主に陽電 子ビームの形状を観測した。ライナックのビーム条件は、 エネルギー:105MeV、パルス幅:2µs、ピーク電流: ~40mA、繰り返し:10pps、コンバーターでのビーム径: ~2cm であった。陽電子輸送系でのコイル電流をH1=12A、

JAERI-Conf 94-003

H2~H5=8A, H6=10A, S1=0A, S2=8A, S3~S7=10A, B1~ B3=10A とし、モデレーターの各層にそれぞれ1、1.1、 1.2、1.3kVの電圧を与え、メッシュをアースにしたとき に得られた像を図-4に示す。図中の縦線は、モデレータ ーに引き出し電圧を印加した時だけ現れることから、こ れが陽電子ビームの像と判断でき、縦線はモデレーター 内のタングステンフォイル間に対応していると考えられ る。陽電子像の大きさは約2cmであること、縦線の数が 5本程度であり各タングステンフォイル間の距離は1cm であることから、約1/3に絞られていることがわかる。 また陽電子像で、左側がかけているのは、陽電子が第1 照射室内の最初の曲部を通過中、あるいは通過した後に ドリフトにより真空配管に当たってしまったためか、あ るいは発生部から引き出されていく途中で削られてしまっ た結果と考えられる。また、下方に明るい部分が見えて いるが、これは引き出し電圧の有無に関わらず現れ、陽 電子引き出し部の磁場強度を変えると像の形状が変化す ることから、モデレーター付近から輸送されてきた電子 の像と考えられる。このように電子と陽電子の像が分離 できているのは、ドリフトにより生じたと考えられる。

6.まとめ

本年度新たに設計・製作した磁場輸送系でのビームラ インを用いて陽電子の発生・輸送を行うことができた。 電子ビームを用いたときの実験結果のまとめを以下に示 す。

・磁場を用いることで、電子をほとんど失うことなく輸送することが可能であることがわかった。

・曲部を通過することで像は若干ひずむが、大きく像の 形状が変化することはなく、また、ドリフトや磁場の漏 れによるビーム軌道のシフトは、補正コイルにより修正 可能であることがわかった。

・電子ビームを引き出し部で十分絞り込む磁場配位では、 像全体としては大幅に縮小することは困難であることが わかった。しかし陽電子に関しては、初期条件が異なる ため、実際に実験で確かめる必要がある。

陽電子発生・輸送実験に関しては、現在のところ発生 を確認できただけだが、電子も同時に輸送されてくると いう、新たな問題も発生した。この問題に対しては、曲 部を通過するときに電子と陽電子は互いに反対方向にシ フトすることから、これを利用し、曲部を出た直後にア パーチャーを挿入し、積極的に電子を排除する方法を検 討中である。



(a) (b) (c)
図-2 電子ビームの像
(a)~(c)はそれぞれ図-1の位置で得られた像







図-4 MCPの蛍光板に現れた像